

Содержание

- Международная конференция Физика.СПб,
20–24 октября 2025 г., Санкт-Петербург

Заварин Е.Е., Родин С.Н., Клюев Б.Ю., Лундин В.В., Николаев А.Е., Артеев Д.С., Сахаров А.В., Цацульников А.Ф.
Управление упругими напряжениями при росте гетероструктур (Al)GaN/SiC 315

Колосько А.Г., Мутыгуллин Б.Э., Филиппов С.В., Попов Е.О., Соков С.А., Нечаев М.С., Лобанов Б.В., Дёмин Г.Д., Мицкевич А.А.
Моделирование профиля распределения электронов по люминесцентному экрану при исследовании полупроводникового полевого катода 319

Харькова А.В., Кочуев Д.А., Вознесенская А.А., Хорьков К.С.
Влияние положения поверхности образца относительно фокальной плоскости оптической системы на эффективность выхода наночастиц ZnS при лазерной абляции 324

Родин В.Д., Аксенов В.Ю., Анкудинов А.В., Большаков В.О., Власов А.С., Жарова Ю.А., Илькив И.В., Левин Р.В., Малевская А.В., Минтаиров А.М.
Тестирование диэлектрических покрытий для исследований элементарных флуктуаций заряда методами сканирующей кельвин-зонд микроскопии 328

Климов А.А., Кунков Р.Э., Лухмырина Т.С., Матвеев Б.А., Ременный М.А.
Высокотемпературные фотодиоды на основе гетероструктур n -InAsSbP/InAs/ p -InAsSbP 333

- XXIX симпозиум „Нанофизика и наноэлектроника“,
Нижний Новгород, 10–14 марта 2025 г.

Хомицкий Д.В., Лаврухина Е.А., Тележников А.В., Жолудев М.С.
Моделирование уровней Ландау, холловского и продольного сопротивления в топологическом андерсоновском изоляторе в квантовой яме HgTe/Hg_{0.3}Cd_{0.7}Te 338

Лаврухина Е.А., Хомицкий Д.В.
Управление локализацией зарядовой и спиновой плотности в двойной квантовой точке на крае топологического изолятора как физическая основа операций с кубитами 344

Новикова О.В., Гусев Е.Э., Епихин А.А., Кушнарев И.В., Иванов П.С., Лебедев Е.А., Дюжев Н.А.
Исследование механических и оптических свойств мембран MoSiN 350

Цуканов Д.А., Азатьян С.Г., Денисов Н.В., Рыжкова М.В.
Исследование роста и электрической проводимости сверхтонких пленок магния на поверхности Si(111), пассивированной висмутом 356

- Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Юшков И.Д., Гисматулин А.А., Камаев Г.Н., Vergnat M., Володин В.А.
Механизм транспорта заряда в МДП-структурах ITO/[GeO_x]_(z)[SiO₂]_(1-z)/n⁺-Si 364

- Физика полупроводниковых приборов

Журавлев М.Н., Земляков В.Е., Гуминов Н.В., Зайцев А.А., Шпаков Д.С., Макарецев И.В., Дудинов К.В., Егоркин В.И.
Исследование характеристик AlGaN/GaN СВЧ-транзисторов с полевыми электродами на подложке кремния 371